

电路工艺加工要求

工艺类型：3.0 μm P 阱硅栅单多晶单铝工艺

工艺参数要求：

序号	参 数 项	器件尺寸	单 位	工艺参数值
1	NMOS V_t	20/3	V	0.9 ± 0.2
3	NMOS BV_{dss}	20/3	V	>16
4	PMOS V_t	20/3	V	0.9 ± 0.2
6	PMOS BV_{dss}	20/3	V	<-17
7	N+ sheet ρ	100/10	Ohm/sq	40 ± 20
8	P+ sheet ρ	100/10	Ohm/sq	80 ± 20
9	Poly sheet ρ	100/10	Ohm/sq	27 ± 5
10	N+ contact	3×3	Ohm/cont	<100
11	P+ contact	3×3	Ohm/cont	<150
12	Metal R sheet ρ		m Ohm/sq.	30 ± 10
15	NMOS V_{tf}	Poly field	V	>18
16	PMOS V_{tf}	Poly field	V	<-19

技术联系人：张瑾

联系电话：18913190678